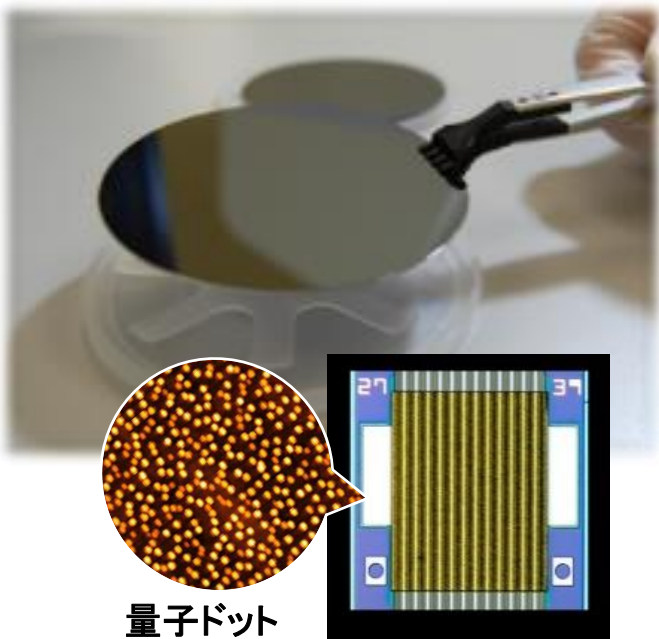


量子ドットレーザ・エピウエハ・ ファウンドリサービス

シリコンフォトニクスに適した1300 nm帯量子ドットレーザ

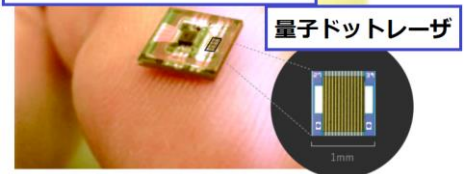
- 最高200 °Cでの安定動作。光電子集積回路の高密度実装化に貢献
- 優れた戻り光耐性でアイソレータ不要、装置の小型・低コスト化に最適
- エピウエハ・チップのカスタム試作から量産まで一貫したサポート



適用例

- シリコンフォトニクス
 - データセンタ内通信
 - スーパーコンピュータ
 - LiDAR (FMCW, ToF)
 - 車載通信
 - 携帯電話基地局通信
- 地下資源探査 (175-200 °C)

シリコンフォトニクスチップ



量子ドットレーザ、ゲインチップ

- 最高200 °Cでの安定動作。レーザアレイによる高密度化可能
- 優れた戻り光耐性(量子ドット<-130dB/Hz・量子井戸<-120dB/Hz at -30dB)
- 高温環境での高い信頼性(推定寿命>30万時間 at 85 °C)
- 用途に応じた広帯域利得スペクトルへのカスタマイズ可能

エピ・ファウンドリサービス

- エピウエハ、回折格子付きウエハ、ウエハプロセス、チップ加工に対応
 - 基板接合用ウエハ、FP/DFBLレーザ、ゲインチップ
 - マルチチャネル構造、フリップチップ実装用構造
- エピ構造、チップデザインのカスタマイズ可能
- 試作から量産まで一貫したサポート



主なラインナップ*

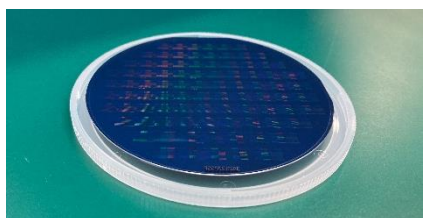
波長	レーザ種類	形態	光出力 (mW)
1300 nm	FP	チップ、TO-CAN	>10
1300 nm	DFB	チップ、TO-CAN	>10
1240 nm	DFB	チップ、TO-CAN	>10
1240-1300 nm	エピ	Wafer	n/a

主なファウンドリサービス*

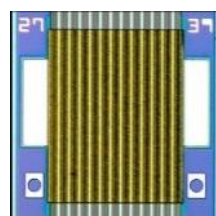
メニュー	内容
エピ	3 inch GaAs基板上エピ
回折格子付きエピ	1stエピ、回折格子形成、埋め込み再成長
ウエハプロセス	CAD作業、マスク作製、ウエハプロセス
チップ加工	バー形成、端面コート、チップ化

プロダクトファミリー

量子ドットウエハ



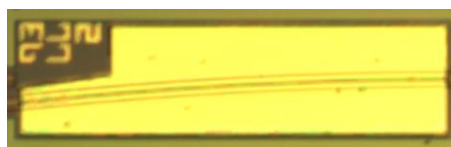
レーザチップ



TO-CANパッケージ



ゲインチップ



*その他の仕様、オプションについてはお問い合わせください。

